

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 25 年 7 月 25 日 (2013.7.25)

【公開番号】特開 2012-99598 (P2012-99598A)  
 【公開日】平成 24 年 5 月 24 日 (2012.5.24)  
 【年通号数】公開・登録公報 2012-020  
 【出願番号】特願 2010-245149 (P2010-245149)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 29/78 (2006.01)

H 0 1 L 29/12 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/28 3 0 1 B

H 0 1 L 29/78 6 5 3 A

H 0 1 L 29/78 6 5 2 T

H 0 1 L 29/78 6 5 2 M

H 0 1 L 29/78 6 5 8 F

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

【手続補正書】  
 【提出日】平成 25 年 6 月 12 日 (2013.6.12)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 0 5  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【 0 0 0 5 】

上述したように、N i 原子および S i 原子を有する電極（電極層）の形成に際して、電極層の電気伝導度を高くするためには、N i の割合を高める必要がある。しかし N i の割合が高められると、電極層形成のためのアニールの際に、炭化珪素基板から電極層の表面へと多くの C 原子が析出してしまふ。このため、電極層の電気伝導度を高くすることと、電極層の表面への C 原子の析出の抑制とを両立させることが困難であった。

【手続補正 2】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 1 5  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【 0 0 1 5 】

上述したように本発明によれば、電極層の電気伝導度を高めることと、電極層の表面への C 原子の析出の抑制とを両立させることができる。